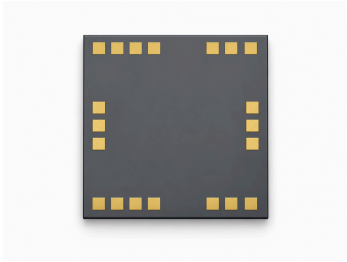


100–20000 MHz GaAs Die conmutador SP3T MMIC — $IL \leq 2.8 \text{ dB}$ (2000–20000 MHz)

100–20000 MHz; Pérdida de inserción (100–2000 MHz) $\leq 1.4 \text{ dB}$; Aislamiento (100–2000 MHz) $\leq 65 \text{ dB}$.



Características RF · TA = +25 °C

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidad
Frecuencia de funcionamiento	f	100	-	20000	100–20000	MHz
Pérdida de inserción (100–2000 MHz)	-	-	-	1.4	f = 100–2000 MHz	dB
Pérdida de inserción (2000–20000 MHz)	-	-	-	2.8	f = 2000–20000 MHz	dB
Aislamiento (100–2000 MHz)	-	-	-	65	f = 100–2000 MHz	dB
Aislamiento (2000–20000 MHz)	-	-	-	43	f = 2000–20000 MHz	dB
VSWR de entrada/salida (conducción)	-	-	1.2	-	-	-
VSWR de entrada/salida (corte)	-	-	1.4	-	-	-
Potencia de entrada en compresión de 1 dB	-	23	-	-	-	dBm

Tensiones de control · TA = +25 °C

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad	Notas
Corriente de reposo de alimentación negativa	-	-	-	0.002	A	-
Corriente de control de entrada	-	-	0.0002	-	A	TTL = +5 V
Tensión de entrada de nivel alto	-	3	-	5.5	V	-
Tensión de entrada de nivel bajo	-	0	-	0.8	V	-

Tensiones de control · TA = +25 °C

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad	Notas
Tensión de alimentación negativa	-	-5.5	-5	-4.5	V	-

Valores límite · Valores límite; no son consignas de funcionamiento normal.

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Potencia de entrada máxima	-	-	-	25	dBm
Temperatura de almacenamiento	-	-65	-	150	°C
Temperatura de funcionamiento	-	-55	-	125	°C
Tensión mínima de alimentación negativa	-	-6	-	-	V

Dimensiones del chip

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones del chip	1.5 × 1.55 × 0.1	mm
Tolerancia del contorno en planta	±100	µm

Asignación de pads de unión

Terminales	Símbolo	mm
2	RFin	0.100 × 0.100
9	RF1	0.100 × 0.100
12	RF2	0.100 × 0.100
15	RF3	0.100 × 0.100
4, 20	VEE	0.100 × 0.100
5, 7	A1	0.100 × 0.100
17, 19	B1	0.100 × 0.100
6	A2	0.100 × 0.100
18	B2	0.100 × 0.100
1, 3, 8, 10, 11, 13, 14, 16	GND	0.100 × 0.100

Registro de la publicación actual · 1.4 · 2026-10-27. Actualización de la descripción o del contenido editorial. Sustituye a la revisión 1.3.

Notas de integración

A1 / B1 (V) = 0; A2 / B2 (V) = 0; RF = RFin ↔ RF1 A1 / B1 (V) = 0; A2 / B2 (V) = 5; RF = RFin ↔ RF2 A1 / B1 (V) = 5; A2 / B2 (V) = 5; RF = RFin ↔ RF3

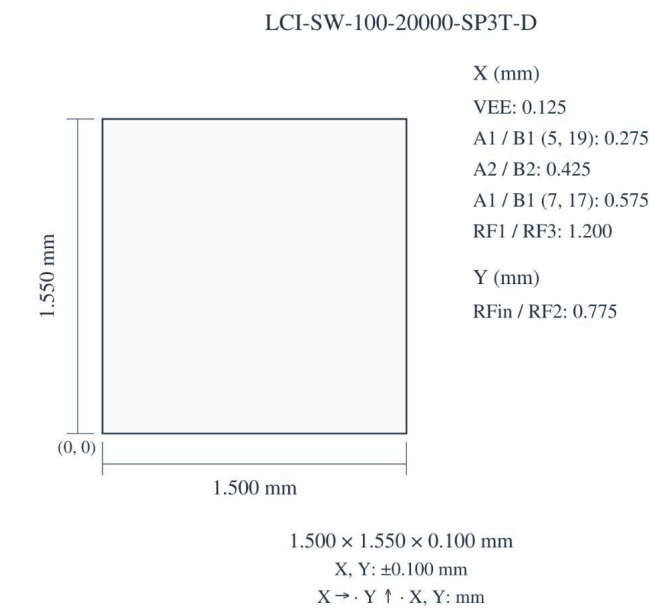
Conexión de los pads

Los pads GND indicados son puntos de masa para pruebas. Para VEE, basta utilizar uno de los pads 4, 20. Para A1 / B1, basta utilizar uno de los pads 5, 7, 17, 19. Para A2 / B2, basta utilizar uno de los pads 6, 18.

Alcance de la referencia mecánica

Contorno y referencias de coordenadas acotadas según la fuente, en mm. No constituye un plano completo de fabricación ni de conexionado por hilo.

Plano dimensional mecánico



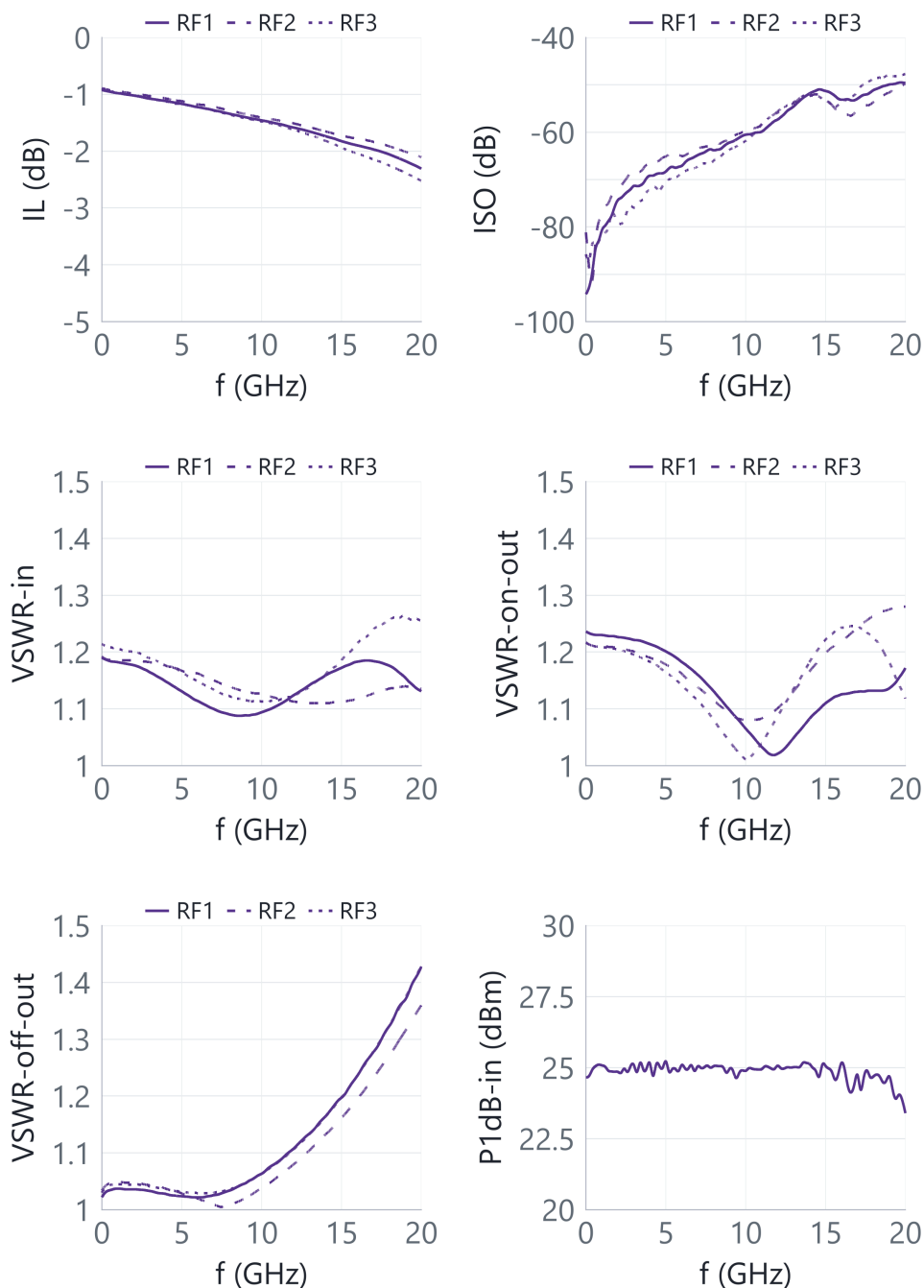
Todas las dimensiones se indican en mm [in].

Curvas de rendimiento

Gráficas de la hoja de datos original. Consultar cada figura junto con las condiciones de funcionamiento indicadas.

Adaptación de salida; Adaptación de entrada; Aislamiento; Pérdida de inserción; Potencia de entrada en compresión de 1 dB.

Gráfico redibujado a partir de la figura original; las lecturas son aproximadas.



[Fuente](#)

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.